

2DK1100L 型硅肖特基整流二极管

1 特性

芯片采用硅外延平面结构，器件有 D2-03B 型玻璃封装。

具有正向压降低、正向导通损耗小，体积小、重量轻，可靠性高的特点。

器件的静电放电敏感度为 4000V，D2-03B 典型重量 235mg。



D2-03B

2 质量等级及执行标准

G 级：QZJ840611；

JCT 级：Q/RBJ 21385-2020。

3 最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型号	I_{FM} mA	V_{RM} V	V_{RWM} V	I_{FSM} $t_p=8.3\text{ms}, T_A=25^{\circ}\text{C}$ A	T_j $^{\circ}\text{C}$	T_{stg} $^{\circ}\text{C}$
2DK1100L	1500	100	80	15	-55~150	-55~150

4 主要电特性

主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

序号	符号	测试条件	规范值
1	正向压降 V_{FM1}	$I_{\text{F}}=1500\text{mA}$	$\leq 0.75\text{V}$
2	正向压降 V_{FM2}	$T_A=-55^{\circ}\text{C}, I_{\text{F}}=1500\text{mA}$	$\leq 1.5\text{V}$
3	反向电流 I_{R1}	$V_{\text{R}}=64\text{V}$	$\leq 5 \mu\text{A}$
4	反向电流 I_{R2}	$T_A=105^{\circ}\text{C}, V_{\text{R}}=64\text{V}$	$\leq 6\text{mA}$

5 特性曲线

5.1 不同温度、不同电压下的反向电流曲线

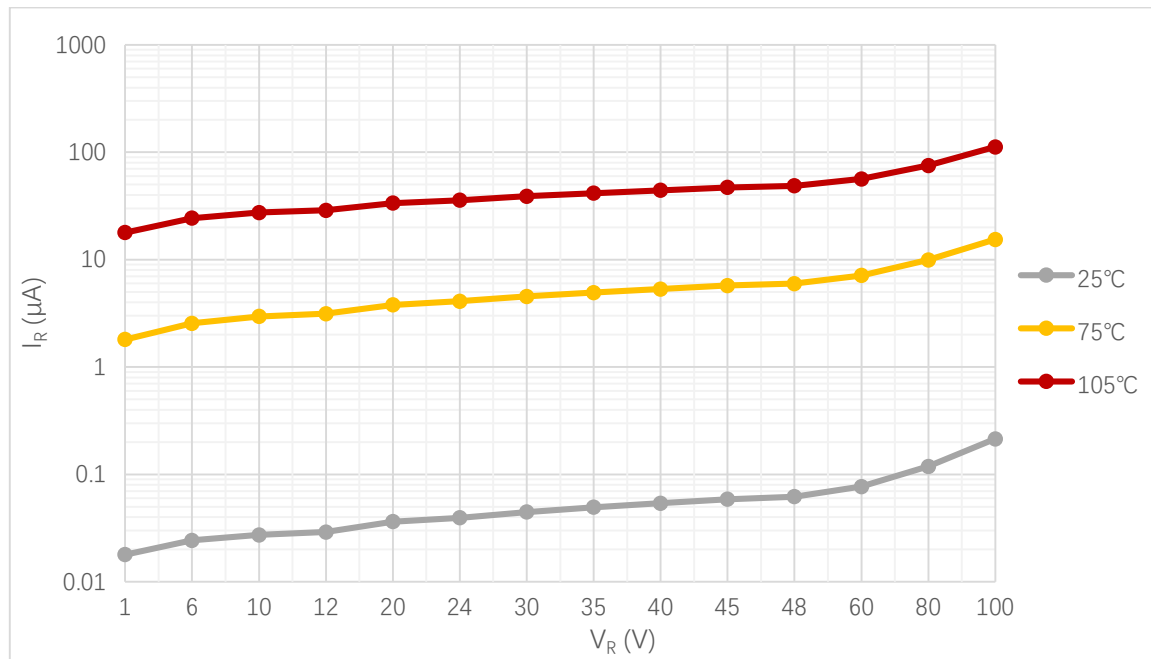


图1 I_R - V_R 特性曲线

5.2 不同温度、不同电流下的正向电压曲线

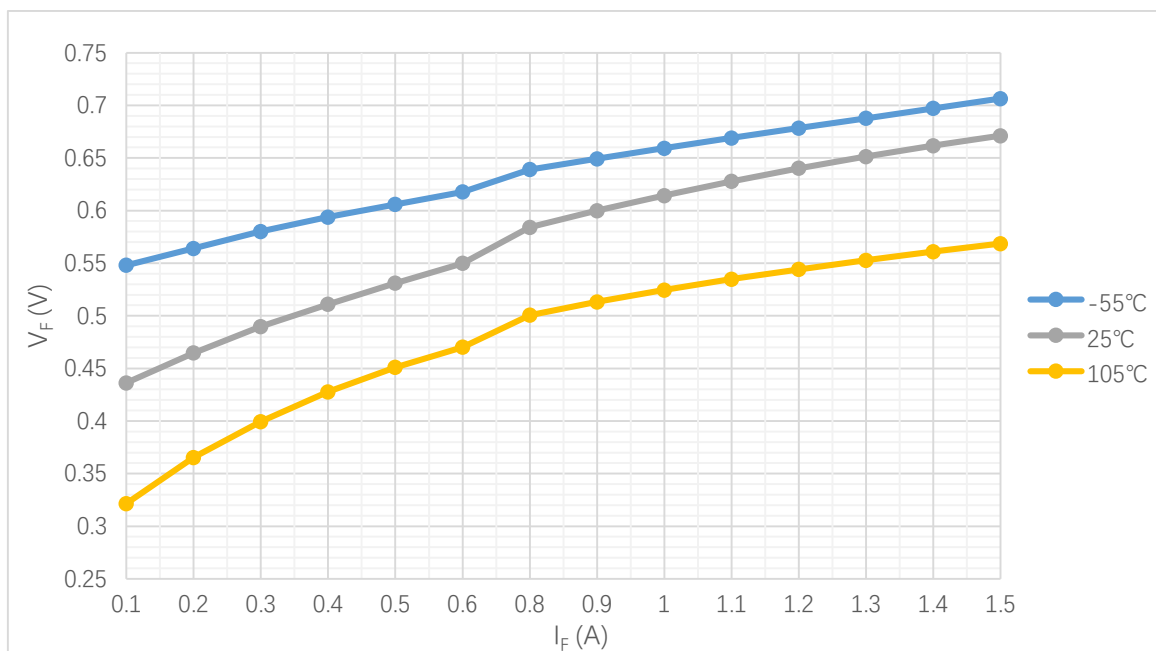
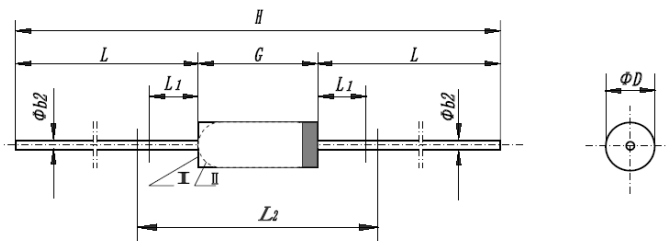


图2 V_F - I_F 特性曲线

6 外观尺寸

单位为毫米



- 注：① L_1 尺寸指在此段内引线直径不予限制，以允许引线涂料和表面少量的凹凸不平存在。
- ② L_2 为引线弯曲成直角后器件安装的最小轴向长度。
- ③ 主体形状允许采用两种形式，见图中轮廓线 I、II。

代号	D2-03B	
符号	最小值	最大值
$\Phi b2$	0.458	0.558
ΦD	—	3.20
G	—	7.62
H	60	—
L	26	—
L_1	—	2.5
L_2	16	—

图 3 D2-03B 外形尺寸